8. ソーダIM電解におけるアニオンの挙動解析 Analysis of Anion Transport in Chlor-Alkali IM Process

西尾拓久央*・梅 村 和 郎*・木 村 達 人* Takuo Nishio, Kazuo Umemura and Tatsuhito Kimura

It's important to understand the behavior of anions such as Cl^- , ClO_3^- and SO_4^{2-} in chlor-alkali IM process for enhancing caustic quality. We analyzed the influence of operating conditions and cell structure on anions transport in a membrane and derived an experimental formula for the estimation of chloride content in caustic soda. This formula was shown to be useful for chlor-alkali producers to optimize the operation conditions using the examples of the application under wide conditions.

1. 緒 言

近年の環境・省エネルギー問題に呼応して、食塩 水を電解し塩素と苛性ソーダを製造する食塩電解プ ロセスは世界的にイオン交換膜法(IM法)へと着実 に切り替わりつつある。

旭硝子では時代の要望に応えるべく常に新しいイ オン交換膜を追求してきた。一方、顧客からは電力 原単位の低減の為に膜の低抵抗化、あるいは設備投 資の軽減の為に6kA/m²以上の高電流密度でも安定 に長期間使用できる膜が求められている。また、昼 間の高い電力時には負荷を下げ夜間の安い電力時に は負荷を上げるシフト運転技術も発達し、そのシフ ト幅は益々大きくなってきている。これらの要望に 応える為に低抵抗型F-8020をはじめとした種々の新 膜を開発・上市してきた。

ここでは、これらの新規な膜の開発のなかで得ら れた様々な知見の中から、イオン交換膜法食塩電解 における製品苛性ソーダ中の不純物となるアニオン の濃度に着目し、運転条件や電解槽構造等がアニオ ンの挙動に与える影響について報告する。

2.IM法とイオン交換膜

Fig. 1にIM法による食塩電解の模式図を示す。イオン交換膜の陽極側に食塩水を、陰極側に水を供給しながら電解すると、陽極反応により陽極室では塩素ガス、陰極反応により陰極室では水素ガスと水酸

*化学品カンパニー事業統括本部開発部

化物イオン(OH⁻)が発生する。またイオン交換膜 は負の荷電を有しているため、膜中をナトリウムイ オン(Na⁺)が選択的に透過し、陰極室では95%以 上の高い電流効率で水酸化ナトリウム(NaOH)が 生成する。





Fig. 2にIM法に用いられるイオン交換膜の模式図 を示す。塩素ガス・高濃度アルカリという過酷な環 境での化学的安定性が求められるため、パーフルオ ロポリマーが用いられる。一般的には、膜はパーフ ルオルスルホン酸ポリマーとパーフルオロカルボン 酸ポリマーの2層構造からなっている。低抵抗の パーフルオロスルホン酸ポリマーを強度保持層とし て使用し、高いカチオン選択透過性を持つパーフル オロカルボン酸ポリマーを電流効率発現層として使



Fig. 2 Design model of ion exchange membrane for chlor-alkali.

用することにより、低抵抗と高電流効率を両立させている。また機械的強度を付与するためPTFE織布で補強されているのが一般的である。

3. 原理、実験方法

3.1 アニオン透過の支配因子

電解中のアニオンの膜透過挙動は、様々な理論的 解釈がなされている⁽¹⁾⁽⁴⁾。ここではアニオンの透過挙 動を理解する上でその助けとなる、代表的な考え方 の一つを上げておく。

アニオンの透過速度はFig. 3に示すように以下の 3つの流速の和で表すことができると考えられてい る。

①膜を隔てたアニオン濃度差による拡散

②電場による電気泳動

③水の電気浸透(透水量の影響)

注)透水量(Na⁺イオンに同伴して透過する水 分子の1Fあたりの透過量。単位=mol/F)

しかしながら、アニオンの透過挙動の全てを3つ の流速によって明確に分離解析することは非常に難 しい。

そこで次節以降では、アニオンとして塩化物イオン (C1⁻)、塩素酸イオン (C10₃⁻)、硫酸イオン (S0₄²⁻)の3つを取り上げ、それぞれの透過の挙動





を、主に運転条件の観点からまとめることを主眼と し、上記3つの支配因子については挙動の理解のた めの、定性的な解析に留めることとした。

3.2 測定膜および測定条件

隔膜には旭硝子(株)製イオン交換膜Flemion[®] F-8020を使用した。電解評価には、下部に塩水供給口 と上部に淡塩水排出口および塩素ガス排出口をもつ チタン製の陽極室と、下部にイオン交換水供給口と 上部に苛性ソーダ排出口および水素ガス排出口をも つニッケル製の陰極室からなる有効電解面積150cm² (縦150mm、横100mm)の小型ラボセルを用いた。 また、供給塩水は当社千葉工場の食塩電解プラント に使用している二次精製済みのものを用いた。

苛性ソーダ中の食塩(NaCl)濃度は分光光度計 (島津製)で測定⁽⁶⁾し、苛性ソーダ中の塩素酸ナトリ ウム(NaClO₃)濃度および硫酸ナトリウム(Na₂SO₄) 濃度はイオンクロマトグラフ(Dionex製)で測定し た。

4. アニオンの挙動解析

4.1 塩化物イオンの挙動解析

4.1.1 運転条件の影響

運転条件によって製品苛性ソーダ中の食塩濃度が 影響を受けることは知られている。ここでは塩化物 イオン(Cl⁻)に対する、苛性ソーダ濃度、塩水濃度、 温度および電流密度の影響について前述の小型ラボ セルを用いて試験した結果をまとめた。

Fig. 4に苛性ソーダ濃度による影響を示す。低苛 性ソーダ濃度領域および高苛性ソーダ濃度領域にお いて食塩濃度が上昇している。前者はCl⁻イオンの透 過を主に支配しているカルボン酸層が膨潤している ためと考えられ、後者はカルボン酸層の過度の収縮 によって官能基とNa⁺イオンの間に強い相互作用が 働き、官能基のイオン排除能が低下したためと考え られる。これは、電流効率すなわちOH⁻イオンの透 過の傾向と似ている。

また、これらの挙動は支配因子①の拡散係数の変 化として理解できる。

Fig. 5に淡塩水濃度の影響を示す。ほとんど依存 性は見られない。

この挙動は2つの解釈ができる。一つは、膜を隔 てた水溶液中のCl⁻イオン濃度差の影響(支配因子①) および、塩水濃度の変化によって大きく変化する透 水量の影響(支配因子③)が共に小さいという解釈。 もう一つは支配因子①と支配因子③の影響は大きい が相殺されてしまう(例えば、塩水濃度が低いと支 配因子①によるCl⁻イオンの透過は減少するが、支配 因子③による透過は増加する)という解釈である。 後述する電流密度の影響の解析を踏まえると前者の 解釈が正しいと考えられるが、立証には至っていな い。

更に、従来の膜においては低塩水濃度領域におい

て食塩の濃度が上昇する傾向が見られたが、イオン 透過チャネルの陰イオン排除能が失われにくい新構 造のカルボン酸ポリマーを採用した結果、陽極側の 環境に影響されにくくなったと考えられる。

Fig. 6に温度の影響を示す。高温領域および低温 領域において食塩濃度が上昇している。最も大きな 因子は温度変化による拡散係数の変化と推定され る。苛性ソーダ濃度特性と同様、高温領域ではカル ボン酸層の膨潤、低温領域ではカルボン酸層の過度 の収縮の影響が見られる。

Fig. 7に電流密度の影響を示す。電流密度が低下 するに従い食塩濃度が上昇している。

この原因は2つあり、1つは電流密度の低下によ る電場の影響の減少(支配因子②)。もう一つは電 流密度の低下による苛性生産速度の低下に伴う相対 的な食塩濃度の上昇である。

上記2つの影響は、NaClの透過速度Nを算出し、 苛性生産速度の影響を取り除くことによって区別で きる。

透過速度Nとしてまとめた結果をFig.8に示す。

実測値をみると電流密度が低下するにつれてNaCl の透過速度Nが上昇していることがわかる。

また次節で詳しく説明するが、本試験は小型ラボ セルを使用しているため、電解槽構造の影響、すな わち電場の小さい電解面周辺部分の影響を大きく受 けている。そこで、その影響を取り除いた透過速度



Fig. 4 Dependence of NaCl content on caustic soda concentration.



Fig. 5 Dependence of NaCl content on anolyte salt concentration.



Fig. 6 Dependence of NaCl content on temp..



Fig. 7 Dependence of NaCl content on C.D..



Fig. 8 Dependence of NaCl transport on C.D..

を真の値として算出し併記した。

真の値をみると支配因子②の電場の影響が著しく 大きいことが更に明確になる。

(注:厳密にいうと支配因子②における電場(電 位差)は電流密度に完全に比例するわけではないが、 挙動解析の理解のため電場の影響を電流密度の影響 と捉えた)

また、電流密度の上昇に伴い透水量が増加するこ とを考えると、逆に支配因子③の電気浸透の影響は 小さいことが示唆される。

4.1.2 電解槽構造の影響

Fig. 9に電解槽の周辺長の影響を示す。Cl⁻イオン は電解面だけでなく周辺部分からも透過する。周辺



Fig. 9 Effect of perimeter.

部分は電場の影響が小さいため、電解面に比べ透過 速度が大きい。その結果、電解面積に対する周辺長 の割合が大きいほど、食塩濃度が上昇する。前節で も触れたが、小型ラボセルではこの影響が無視でき ないほど大きくなる。このことは支配因子②の影響 として説明できる。

また、電解面積は同程度でありながら、食塩濃度 の値に差が生じる場合がある。これは周辺部のシー ル構造や電極距離を調整するために挿入されたス ペーサーの構造によって生じる。

シール構造の影響の一例として、隔膜をシールす るために設置してある陽極側と陰極側のガスケット の相対位置の影響をFig. 10に示す。



Fig. 10 Effect of sealing system.

ここでは、前述の有効電解面積 150cm²(縦 150mm,横100mm)の小型ラボセルにおいてEPDM 製ゴムシート(厚さ1mm)をガスケットとし、側辺 のシール構造を変えた以下の3つを比較した。

- 1) 陰極ガスケット5mm内ずれ
- 2) 陽極ガスケット5mm内ずれ
- 3) 両ガスケットを内ずれさせない
- 注) ここでいう「内ずれ」とは、相対するガス ケットに対し、電解面側にずれた状態を示す。 例えば、「1) 陰極ガスケット5mm内ずれ」 とは、陽極ガスケットに対し、陰極ガスケッ トを電解面側に5mmずらした状態に構成する ことを意味する。

結果から、陰極ガスケット内ずれの構造は食塩濃 度を上昇させることが確認された。これは内ずれし た陰極ガスケット内の苛性濃度が著しく低下し膜の カルボン酸層が膨潤したためと考えられる。

4.1.3 水酸化ナトリウム中の食塩濃度

以上のデータをもとに苛性中の食塩濃度を求める 推算式を導いた。Fig. 11に推算式を示す。

ここで、推算式について簡単に説明する。右辺の 第1項は電解面からの塩化物イオンの透過速度を、 第2項は周辺部からの透過速度を示す。

第2項のL/S₁は、前述の**Fig. 9**の実験結果から周辺 部の塩化物イオンの透過速度がL(周辺長)/S₁(電 解面積)に比例することが確認されたことを根拠と している。

運転条件の4つ(苛性ソーダ濃度、塩水濃度、温 度、電流密度)のうち、塩水濃度のパラメーターを 推算式から除外しているのは、前述したFig.5の実 験結果から塩水濃度の影響が非常に小さいことが確 認されたためである。

残り3つ(苛性ソーダ濃度、温度、電流密度)の パラメーターの影響はいずれもN=Aexp(-B×P) の式で近似することにした。これは、非通電下にお いて、カルボン酸ポリマーの単膜によるアニオンの 拡散挙動がD=Aexp(-B×P)の式に従う^{(4),64/8}ことか ら、通電下における多層構造膜によるアニオンの透 過挙動の近似にも適用できると考えたからである。

注) Pは苛性ソーダ濃度(N)、絶対温度(K)の逆 数を表す。

 $\mathsf{N} = \alpha \exp\left(-\beta \cdot \mathsf{CD} \cdot \gamma \cdot \mathsf{C}_{\mathsf{NaOH}} \cdot \delta \cdot 1/T\right) + \mathsf{L}/\mathsf{S}_{1} \cdot \varepsilon \exp\left(-\gamma \cdot \mathsf{C}_{\mathsf{NaOH}} \cdot \delta \cdot 1/T\right)$

N: Diffusion speed of Cl ion (mmol/m²/Hr)



Fig. 11 Experimental formula for estimation.



Fig. 12 Estimation for shift operation.

膜に関する係数 $\alpha \sim \epsilon$ は、前述の小型ラボセルに よって得られたデータを上記式で近似することによ り求めた。

注) PはCD、C_{NaOH}、1/Tを示し、Aはα、ε、Bは β、γ、δにそれぞれ対応する。

また、第2項に電流密度のパラメーターがないの は、周辺部はほとんど電流が流れていないためであ る。

この推算式はカルボン酸層が著しく収縮し電流効 率が低下するような低温領域や高苛性ソーダ濃度領 域には適用できない。

この推算式は様々な運転条件かつ様々な電解槽に おいて広い範囲で適用できることが確認された。

ー例としてFig. 12に大幅シフト運転を想定した、 0.5kA/m²におけるパイロットセルの実測値と推算値 の比較データを示す。

実測値と推算値はかなり一致しており、0.5kA/m² という低い電流密度においても設備能力や電流効率 の発現領域を踏まえて、食塩濃度を低減するための 最適領域を選定できる。

4.2 塩素酸イオンおよび硫酸イオンの挙動解析4.2.1 塩素酸イオンの挙動解析

製品苛性ソーダ中のNaClO₃濃度も運転条件によっ て影響を受けることが知られている。

特に供給塩水中のClO₃⁻イオン濃度が高いと製品苛 性中のClO₃-濃度が上昇することは、すでによく知ら れている^のため割愛するが、これは支配因子①の影 響として説明できる。

ここでは、前節のCl⁻イオンの挙動と同様に苛性 ソーダ濃度、塩水濃度、温度、電流密度の影響につ いてラボセルを用いて試験した結果をまとめた。

Fig. 13に苛性ソーダ濃度による影響を示す。低苛 性ソーダ濃度領域においてNaClO3濃度が上昇してい る。これはCl⁻イオンの透過と同様にカルボン酸層が 膨潤しているためと考えられる。

また、高苛性ソーダ濃度領域におけるNaClO₃濃度 の上昇もCl⁻イオンの挙動と同じと考えられる。



Fig. 13 Dependence of NaClO₃ content on caustic soda concentration.

Fig. 14に淡塩水濃度の影響を示す。Cl⁻イオンと 同様にほとんど依存性は見られない。

低濃度側でややNaClO₃濃度の上昇がみられるが、 これは供給塩水中のClO₃⁻イオン濃度を一定にしてい ても、淡塩水濃度を下げるために供給塩水流量を下 げると、セル内における塩水の滞留時間が長くなり、 結果としての淡塩水中のClO₃⁻イオン濃度が上昇し、 濃度差による拡散すなわち支配因子①の影響が大き くなった為と考えられる。

Fig. 15に温度の影響を示す。Cl⁻イオンの透過と 同様に高温領域においてNaClO₃濃度が上昇してい る。



Fig. 14 Dependence of NaClO₃ content on anolyte salt consentration.



Fig. 15 Dependence of NaClO₃ content on temp..



Fig. 16 Dependence of NaClO₃ content on C.D..

Fig. 16に電流密度の影響を示す。Cl⁻イオンの解 析と同様に透過速度Nも**Fig. 17**にまとめた。

電流密度が低下するに従いNaClO3濃度が上昇して いるのはCl-イオンと同じであるが、透過速度Nは電 流密度に依存せず、Cl-イオンと大きく異なることが わかる。これはClO3-イオンはCl-イオンに比べ、支 配因子②の影響が小さいことを示唆している。さら に電場の影響を受けにくい点から、電解槽構造によ る影響が比較的小さいことも理解できる。

32%NaOH, 200g/l, NaClO3=4g/l in Brine 2.0 NaCIO₃ N (m mol/Hr/m²) 90deg-C 1.5 85deg-C 1.0 ۲ • 0.5 0.0 4 8 10 0 2 6 C.D. (kA/m²)

Fig. 17 Dependence of NaClO₃ transport on C.D..

4.2.2 硫酸イオンの挙動解析

製品苛性ソーダ中のNa₂SO₄濃度も運転条件によっ て影響を受けることが知られている。

以下、Cl⁻イオン、ClO₃⁻イオンと同様に苛性ソー ダ濃度、塩水濃度、温度、電流密度の影響について ラボセルを用いて試験した結果をまとめた。

Fig. 18に苛性ソーダ濃度による影響を示す。低苛 性ソーダ濃度領域および、高苛性ソーダ濃度領域に おけるNa₂SO₄濃度の上昇はCl⁻イオンおよびClO₃⁻イ オンの透過挙動と同様と考えられる。

Fig. 19に淡塩水濃度の影響を示す。Cl⁻イオン、ClO₃⁻イオンと同様にほとんど依存性は見られない。

Fig. 20に温度の影響を示す。Cl⁻イオン、ClO₃⁻イオンと同様に高温領域においてNa₂SO₄濃度が上昇している。



Fig. 18 Dependence of Na₂SO₄ content on caustic soda concentration.



Fig. 19 Dependence of Na_2SO_4 content on anolyte salt concentration.



Fig. 20 Dependence of Na₂SO₄ content on temp..



Fig. 21 Dependence of Na₂SO₄ content on C.D..

Fig. 21に電流密度の影響を示す。Cl⁻イオン、ClO₃⁻イオンの解析と同様に透過速度Nも**Fig. 22**にまとめた。

Cl⁻イオン、ClO₃⁻イオンと大きく異なりNa₂SO₄濃 度は電流密度に依存しない。また透過速度Nは電流 密度にほぼ正比例の関係を示し、Cl⁻イオン、ClO₃⁻ イオンと大きく異なることがわかる。

これはSO₄²⁻は支配因子②の影響がCl⁻イオン、 ClO₃⁻イオンに比べて極めて小さいことを示唆してい る。

このことから、電解槽構造による影響が無視でき るレベルであることが理解できる。

一方、透過速度Nが電流密度にほぼ正比例である



Fig. 22 Dependence of Na₂SO₄ transport on C.D..

ことと、透水量から推算される水移動速度が電流密 度にほぼ正比例であることから、支配因子③の影響 が大きいことが考えられるが、一方で淡塩水濃度に おける依存性が明確にみられないことなど、透過挙 動に不明な部分が残る。

5.結 言

イオン交換膜法食塩電解における製品苛性ソーダ 中のアニオン濃度に着目し、Cl-イオン、ClO₃-イオ ンおよびSO4²⁻イオンの挙動について主に運転条件の 影響の観点から解析した。特に電場の影響を受けや すいCl⁻イオンについては電解槽構造による影響につ いても解析し、製品苛性中の食塩濃度を予測できる 半経験的な推算式を導くことができた。この推算式 は苛性品質を重要視するクロアリメーカーにおいて は運転条件を最適化する上で有用と思われる。

今後も基礎的な解析を含めた技術開発を進め電解 技術の発展に貢献したいと考えている。

一参考文献一

- (1) 数原学ほか, ソーダと塩素, 37, 357 (1986).
- (2) S. A. Perusich and S. M. Reddy, J. Applied Electrochem., 31, 421 (2001).
- (3) 木村達人ほか,第27回電解技術討論会講演要旨集 95 (2003).
- (4) C. P. Chen and B. V. Tilak; J. Applied Electrochem., 26, 235 (1996).
- (5) 無機応用比色分析編集委員会編,「無機応用比色分析 2」, 共立出版(株) (1974), p. 4.
- (6) T. Berzin, 152^{ad} National Meeting of the Electrochemical Society, Atlanta, Oct., (1997).
- (7) H. L. Yeager, B. kipling and R. L. Doston, J. Electrochem. Soc., **127**, 303 (1980).
- (8) R. S. Yeo and J. McBreen, J. Electrochem. Soc., 126, 1682 (1979).